06;07

Динамика оптической записи информации на тонких слоях халькогенидных стеклообразных полупроводников

© Н.А. Богословский, К.Д. Цэндин

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург E-mail: bogoslowsky@mail.ru

Поступило в Редакцию 1 декабря 2006 г.

Исследуются временная зависимость и пространственное распределение температуры в пленках халькогенидных стеклообразных полупроводников (ХСП) при лазерной записи информации. Предлагается модель, описывающая динамику процесса нагрева пленки лазерным импульсом. Проводится анализ теоретических и экспериментальных данных. Рассматривается методика определения некоторых физических величин, характеризующих материал пленки.

PACS: 44.35.+c

В работе [1] исследуются фазовые переходы в ХСП, на которых основаны процессы лазерной записи информации на пленках ХСП, происходящие при воздействии на пленку импульсами лазерного излучения. В этой работе при помощи лазерных и электрических импульсов длительностью от 1 до $100 \, \mu$ s исследуются пленки с повышенной склонностью к кристаллизации состава Te_{0.81}Ge_{0.15}As_{0.04}.

Для термически закристаллизованных пленок в работе измерены временные зависимости мощности W_1 , необходимой для прожигания дырки, и мощности W_2 , просветляющей пленку в 2 раза в результате частичной аморфизации. Исследования проводились на пленках толщиной

1

около 0.1 µm, полученных испарением исходного материала в вакууме на стеклянные подложки.

В работе получено, что при временах более 3μ s мощности W_1 и W_2 отличаются на 10-20% и не зависят от длительности импульса. Рассчитанное в работе собственное время тепловой релаксации пленки толщиной 0.1 µm составляет 0.03 µs; таким образом, при временах более 3 µs в пленке устанавливается тепловое равновесие. Однако при временах меньше 3 µs мощности, необходимые для частичного просветления и для прожигания дырки, существенно различаются, так при временах порядка 0.3 µs мощности различаются на порядок. В работе это объясняется существенным перегревом пленки до температуры 2250 К и выше. Строго говоря, такая температура должна неизбежно приводить к разрушению кристаллической решетки. Однако из-за малых времен процесса может возникнуть неравновесное распределение температуры. Электроны, поглощающие большую часть лазерного излучения, рассеивают энергию, не успевают передать ее решетке. В результате решетка в течение всего процесса не испытывает значительного перегрева. Возможен лишь незначительный перегрев в течение короткого времени, который, однако, не успевает разрушить кристаллическую решетку.

В настоящей работе предлагается другой механизм, объясняющий сильное различие между указанными мощностями. Исследуется динамика изменения температуры пленки Te_{0.81}Ge_{0.15}As_{0.04} при воздействии на нее импульса лазерного излучения.

Распределение температуры в пленке описывается уравнением теплопроводности

$$\rho\left(C + L_m\delta(T - T_m)\right)\frac{\partial T}{\partial t} = k\frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + k\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial T}{\partial r}\right) + Q(r, z).$$
(1)

Здесь ρ — плотность, C — удельная теплоемкость, L_m — скрытая теплота плавления, T_m — температура плавления, k — коэффициент теплопроводности, Q(r, z) — функция, описывающая выделение в пленке тепла [2,3].

Поглощение лазерного излучения описывается законом Бугера-Ламберта-Бэра [4]

$$I = I_0 \exp(-\mu z).$$

Здесь I — мощность поглощаемого излучения на глубине z, I_0 — мощность поглощаемого излучения на поверхности пленки, μ — линейный коэффициент поглощения. В решении мы пренебрегаем различием

в коэффициентах поглощения кристалла и расплава, так же считаем, что при образовании дырки существенно не изменяется поглощаемая мощность.

Будем считать, что энергия распределяется в пучке по закону

$$I = I_0 \exp\left(-\frac{r^2}{R^2}\right).$$

Здесь I — мощность излучения на расстоянии r от центра луча, I_0 — мощность излучения в центре лазерного луча, R — характерный размер порядка длины волны лазерного излучения. Таким образом, источник тепла в уравнении описывается формулой

$$Q(r, z) = I_0 \exp\left(-\mu z - \frac{r^2}{R^2}\right).$$

Граничные и начальные условия задаем в виде

$$T\big|_{r=\infty} = T_0,$$

$$\frac{\partial T}{\partial z}\Big|_{z=0} = 0, \quad T\big|_{z=d+\Delta d} = T_0,$$

$$T(z, r)\big|_{r=0} = T_0.$$

Здесь T_0 — начальная температура, равная 290 К; d — толщина пленки; Δd — расстояние в подложке, на котором температура по предположению постоянна. Граничные условия по оси z отражают отсутствие теплообмена с верхней границы пленки и отсутствие существенного нагрева массивной подложки. Величина Δd выбрана равной $0.1\,\mu$ m, также считалось, что на расстоянии $L = 2.5\,\mu$ m от оси пленка не нагревается, т. е. это расстояние соответствует бесконечности по радиусу. На рис. 1, *b* изображена пленка с обозначенными на ней характерными расстояниями.

Решение этого уравнения можно найти численно, для этого было численно решено уравнение теплопроводности, не содержащее скрытой теплоты плавления при температуре, меньшей температуры плавления. При достижении в некоторой области пленки температуры плавления считалось, что в этой области температура перестает меняться и начинается процесс плавления. Считалось, что на плавление идет разность поглощаемой энергии и энергии, уходящей на теплопроводность.



Рис. 1. *а* — зависимость мощности, необходимой для образования дырки, *I* и мощности, просветляющей пленку вдвое, *2* от времени; *b* — схема пленки с обозначенными на ней характерными величинами.

Для решения была взята пленка толщиной $0.5\,\mu$ m и радиусом $2.5\,\mu$ m. Характерный размер пучка лазерного излучения равнялся $1\,\mu$ m. При решении пленка была разбита на элементарные ячейки, размер которых был выбран равным $0.01\,\mu$ m. Задача решалась методом пошагового подсчета температуры и ее производных в каждой ячейке. Затем по уравнению вычислялась температура ячейки в следующий момент времени. Шаг по времени изменялся в зависимости от мощности импульса. Для проверки устойчивости решения задача решалась при одинаковой мощности источника для различных шагов по времени.

В [1] приведен график экспериментально измеренной зависимости мощности, необходимой для прожигания дырки, и мощности, необ-

ходимой для частичного просветления пленки от времени. Этот график отображен на рис. 1, *а*. Экспериментальные данные на рисунке отмечены круговыми точками для случая частичного просветления и квадратными точками для случая прожигания дырки.

Аналогичная зависимость была получена численно. При этом считалось, что просветление происходит сразу же при достижении температуры плавления, а прожигание дырки происходит после полного плавления пленки в некоторой области. На рис. 1, a этим зависимостям соответствуют кривые 2 и 1 соответственно. Из графиков видно, что нижняя кривая, соответствующая частичному просветлению пленки, хорошо соответствует экспериментальным данным. Это показывает, что просветление происходит при прогреве до температуры плавления и оправдывает выбор модели. Кривая, соответствующая прожиганию дырки, не настолько хорошо соответствует экспериментальным данным. Это может быть связано с тем, что прожигание дырки происходит постепенно и момент прожигания дырки определенного размера достаточно трудно точно определить.

На рис. 1, *а* пунктиром построены зависимости мощностей, которые бы имели место при отсутствии теплообмена. При малых временах длительности импульса эти зависимости практически совпадают с кривыми *1* и *2*. Видно, что теплота фазового перехода (ей соответствует расстояние между двумя пунктирными линиями) превосходит энергию, необходимую для плавления (соответствует нижней пунктирной кривой) приблизительно в 7 раз. Однако при длительности импульса, большей 3μ s, энергия, которая расходуется на теплообмен (соответствует расстоянию от пунктирной линии до соответствующей кривой) в десятки раз превосходит теплоту плавления. Таким образом, кривые *1* и *2* сближаются. Т.е. показано, что различие в мощностях не связано с существенным перегревом.

Одной из проблем при решении данной задачи является отсутствие каких-либо данных о величинах, характеризующих пленку Te_{0.81}Ge_{0.15}As_{0.04}. При решении задачи были выбраны следующие значения: теплота плавления $L_m = 184$ J/g, теплоемкость C = 0.224 J/g · K, коэффициент теплопроводности k = 0.013 W/cm · K. Зависимость величин от температуры не учитывалась. Таким образом, показано, что если принять указанные значения констант, то вся область между кривыми 1 и 2 соответствует скрытой теплоте плавления. Вид графиков может быть другим, если взять другие значения констант. Главным образом



Рис. 2. Распределение температуры в пленке в случае адиабатического нагрева в моменты: $a - t = 0.15 \,\mu$ s, $b - t = 0.3 \,\mu$ s, $c - t = 0.7 \,\mu$ s, $d - t = 1.5 \,\mu$ s. Буквами *m* обозначены области, в которых происходит плавление, h — область, в которой образовалась дырка.

вид графиков может быть изменен за счет скрытой теплоты плавления, например, если взять значение L_m порядка 120 J/g, то кривая *1* будет хорошо соответствовать точкам при временах более 1 μ s, однако при меньших временах будет наблюдаться перегрев на несколько сотен градусов.

Рассмотрим вопрос о распределении температуры в пленке, а также о зависимости температуры от времени. На рис. 2 показано распределение температуры при мощности импульса W_F . В этом случае можно считать, что нагрев пленки происходит адиабатически, в (1)



Рис. 3. Распределение температуры в пленке в случае стационарного процесса в моменты: $a - t = 0.15 \,\mu$ s, $b - t = 60 \,\mu$ s, $c - t = 140 \,\mu$ s, $d - t = 450 \,\mu$ s. Буквами *m* обозначены области, в которых происходит плавление, h — области, в которых образовались дырки.

слагаемое, соответствующее нагреву, в 20 раз превосходит слагаемое, соответствующее теплообмену, поэтому теплообменом можно пренебречь. На рис. 2, a показана температура в пленке в момент достижения в точке N температуры плавления, на рис. 2, b — в момент, когда пленка в точке N расплавилась на 10%, на рис. 2, c — когда пленка в точке N расплавилась на 30%, и на рис. 2, d — в момент образования дырки в точке N. Цифрами на рисунке помечены температуры изотерм. На рис. 3 показано распределение температуры в пленке при малой мощности импульса W_S . В таком случае можно говорить о стационарном режиме,

поскольку в течение большей части времени практически не происходит изменения температуры. При такой мощности в (1) слагаемое, соответствующее теплообмену, в 20 раз больше слагаемого, соответствующего нагреву. На рис. 3, *а* показана температура в момент достижения в точке *N* температуры плавления, на рис. 3, *b* — в момент, когда пленка в точке *N* расплавилась на 10%, на рис. 3, *c* — в момент, когда пленка в точке *N* расплавилась на 30%, и на рис. 3, *d* — в момент образования дырки в точке *N*.

Из рисунков видно существенное различие между этими случаями. В случае адиабатического нагрева наблюдается увеличение области расплава, в то время как в стационарном случае плавление пленки происходит в постоянной области, с течением времени меняется лишь степень расплавленности, увеличение расплавленной области происходит лишь после частичного прожигания дырки. Видно, что в стационарном режиме температура во всем объеме пленки остается постоянной во времени, что и позволяет называть режим стационарным.

Таким образом, установлено, что присутствие резличия в мощностях может быть объяснено расходом существенной доли энергии на плавление пленки. При больших же временах различие мало из-за расхода большей части энергии на теплообмен. Очевидно, что такой механизм не отвергает любые другие эффекты, однако видно, что именно скрытая теплота плавления является главной причиной различия в мощностях. С помощью численного моделирования возможно путем сравнения графиков и подбора наиболее подходящих значений оценить некоторые параметры материала пленки: теплоемкость, теплопроводность, теплоту плавления и коэффициент поглощения.

Список литературы

- [1] Лебедев Э.А., Цэндин К.Д. // ФТП. 1998. Т. 32. № 8. С. 939–943.
- [2] Ковалев А.А., Жвавый С.П., Зыков Г.Л. // ФТП. 2005. Т. 39. В. 11. С. 1345.
- [3] Жвавый С.П., Зыков Г.Л. // ФТП. 2006. Т. 40. В. 6. С. 652.
- [4] Шварц К. Физика оптической записи в диэлектриках и полупроводниках. Рига: Зинатне, 1986.